

2DK0200UR 型硅肖特基开关整流二极管

1 特性

芯片采用硅外延平面结构， DO-213AA 型玻璃封装。
具有正向压降低、正向导通损耗小，体积小、重量轻，可靠性高的特点。
器件的静电放电敏感度为 3A 级，4000V。
DO-213AA 典型重量 35mg。



DO-213AA

2 质量等级及执行标准

G 级，QZJ840611。
JCT 级，ZZR-Q/RBJ30005-2010。

3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

符号 型号	V_M (V)	V_{RM} (V)	I_{FM} (mA)	I_{FSM} (A)	T_{JM} ($^{\circ}\text{C}$)	T_{stg} ($^{\circ}\text{C}$)	$R_{th(j-A)}$ $^{\circ}\text{C}/\text{W}$
2DK0200UR	50	40	200	2.0	150	-55~150	325

4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

电参数	测试条件	极限值		单位
		最小值	最大值	
V_{FM1}	$I_F=20\text{mA}$	—	0.62	V
V_{FM2}	$I_F=200\text{mA}$	—	1.0	
V_{FM3}	$T_A=125^{\circ}\text{C}$, $I_F=200\text{mA}$	—	0.90	
V_{FM4}	$T_A=-55^{\circ}\text{C}$, $I_F=200\text{mA}$	—	2.0	
I_{R1}	$T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_R=10\text{V}$	—	5.0	μA
I_{R2}	$T_A=125^{\circ}\text{C}$, $V_R=10\text{V}$	—	5.0	mA
V_{BR1}	$I_R=10\mu\text{A}$	50	—	V
V_{BR2}	$T_A=-55^{\circ}\text{C}$, $I_R=10\mu\text{A}$	50	—	
C_{tot}	$V_R=10\text{V}$, $f=1\text{MHz}$	—	50	pF

5 原理图

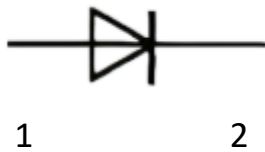


图 1 二极管原理图

注：二极管 1 端为正极，2 端为负极。

6 外观尺寸

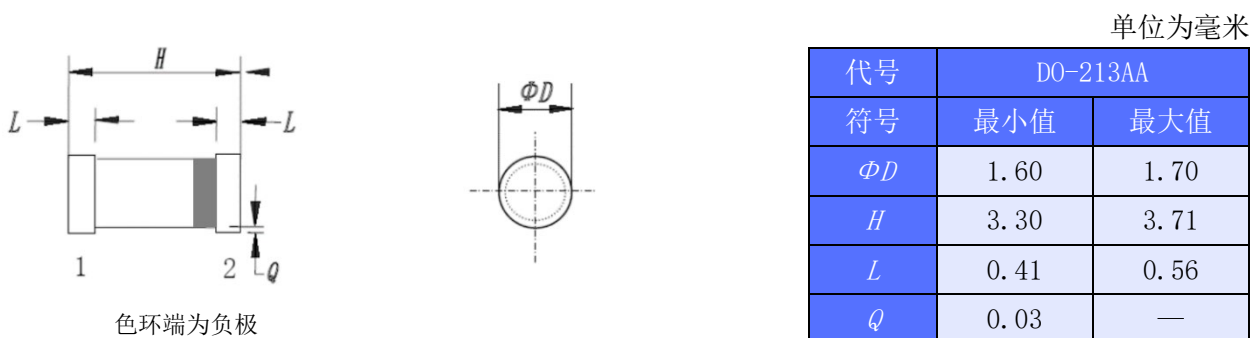


图 2 DO-213AA 外形尺寸

7 注意事项

产品手册将不定期更新，请用户务必在使用我单位产品前通过官方渠道获取产品手册的最新版本，对产品手册有疑问之处请与我单位联系。

7.1 产品焊接

焊接时推荐使用中性焊接剂、回流焊方式焊接。推荐使用约 183℃ 的低熔点焊料焊接，回流焊区温度一般高于焊膏熔点 20℃～25℃，再流焊时间为 6～10s，再流焊温度可为 210℃～230℃，最高不超过 235℃；波峰焊焊接温度为 250±5℃。

7.2 涂敷防护

推荐使用喷涂方式进行三防漆的保型涂敷，玻璃封装产品注意玻璃体及玻璃体与印制板接触的部位不能有三防漆，也不能和周围的大器件桥连。如需进行粘固或固封等操作，请充分验证后进行。